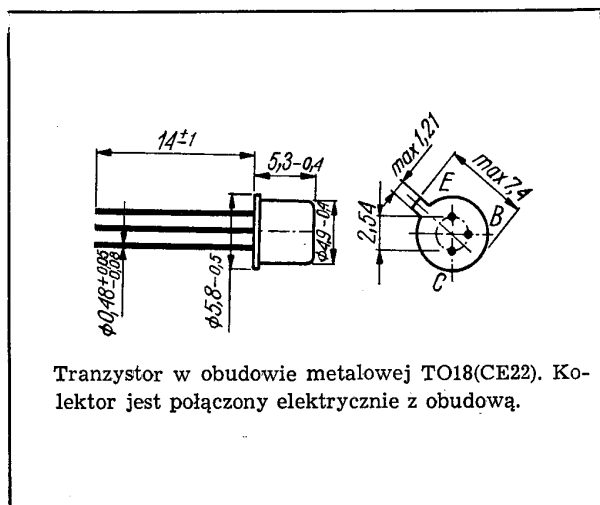


Tranzystor krzemowy epiplanarny przeznaczony do stosowania w układach szybko przełączających małej i średniej mocy.  
Kolektor tranzystora jest połączony elektrycznie z obudową.



Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Kolektor jest połączony elektrycznie z obudową.

**DANE TECHNICZNE**

**Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych**

Napięcie kolektor-baza	$U_{CB0}$	40	V
Napięcie kolektor-emiter	$U_{CE0}$	15	V
Napięcie emiter-baza	$U_{EB0}$	5	V
Prąd kolektora	$I_{CM}$	500	mA
Prąd bazy	$I_{BM}$	50	mA
Moc strat	$P_C$	360	mW
Temperatura złącza	$t_j$	423	K
		(150	°C)
Zakres temperatury otoczenia	$t_{amb}$	233...373	K
		(-40...+100	°C)

**Parametry statyczne**

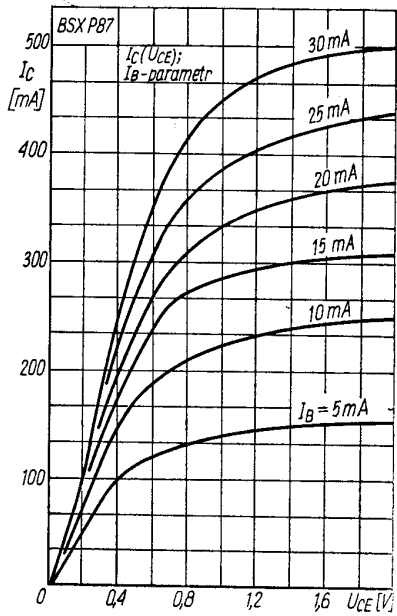
przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)			
Napięcie przebicia kolektor-baza		<u>min.</u>	<u>maks.</u>
przy $I_{CB0} = 10 \mu A$	$U_{(BR)CB0}$	15	— V

Napięcie przebicia kolektor-emiter przy $I_C = 30$ mA	$U_{(BR)CE0}$	40	—	V
Napięcie przebicia kolektor-emiter przy $I_C = 30$ mA, $R_{BE} = 10 \Omega$	$U_{(BR)CER}$	20	—	V
Napięcie przebicia emiter-baza przy $I_{EB0} = 10 \mu A$	$U_{(BR)EB0}$	5	—	V
Prąd wsteczny kolektora przy $U_{CB0} = 20$ V	$I_{CB0}$	—	25	nA
przy $U_{CB0} = 20$ V, $t_{amb} = 373$ K (100°C)	$I_{CB0}$	—	8	$\mu A$
Prąd wsteczny emitera przy $U_{EB0} = 4$ V	$I_{EB0}$	—	100	nA
Napięcie nasycenia baza-emiter przy $I_C = 10$ mA, $I_B = 1$ mA	$U_{BEsat}$	—	0,85	V
Napięcie nasycenia kolektor-emiter przy $I_C = 200$ mA, $I_B = 20$ mA	$U_{CEsat}$	—	0,7	V
Współczynnik wzmocnienia prądowego przy $I_C = 10$ mA, $U_{CE} = 1$ V	$h_{21E}$	30	120	—
przy $I_C = 10$ mA, $U_{CE} = 1$ V, $t_{amb} = 233$ K (-40°C)	$h_{21E}$	15	—	—
przy $I_C = 500$ mA, $U_{CE} = 5$ V	$h_{21E}$	10	—	—

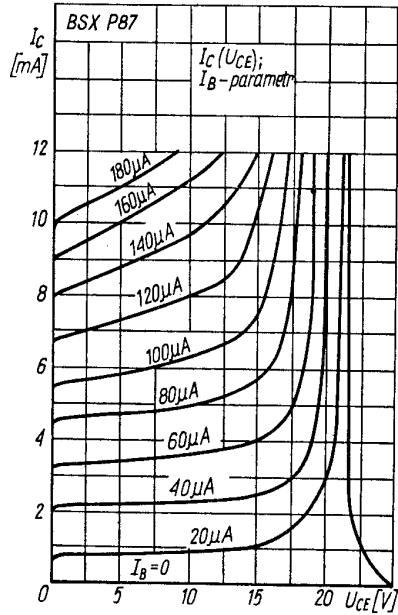
**Parametry dynamiczne**

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)				
		<u>min.</u>	<u>maks.</u>	
Częstotliwość przeniesienia przy $I_C = 20$ mA, $U_{CE} = 10$ V	$f_T$	300	—	MHz
Pojemność kolektora przy $U_{CB0} = 10$ V	$C_C$	—	6	pF
Czas włączania przy $I_C = 200$ mA, $I_B = 40$ mA	$t_{ON}$	—	40	ns
Czas wyłączenia przy $I_C = 200$ mA, $I_{B1} = 40$ mA, $I_{B2} = -20$ mA	$t_{OFF}$	—	40	ns

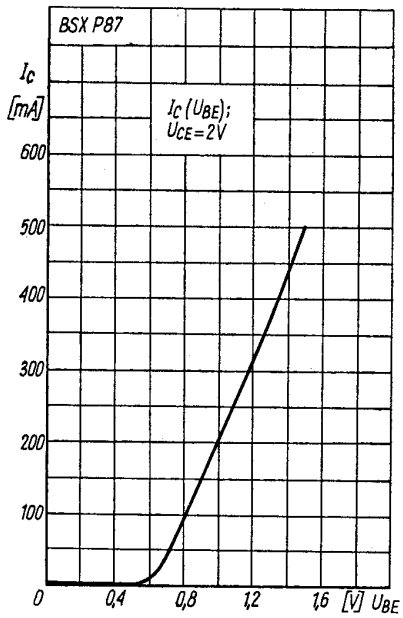
**SWW 1156-223**



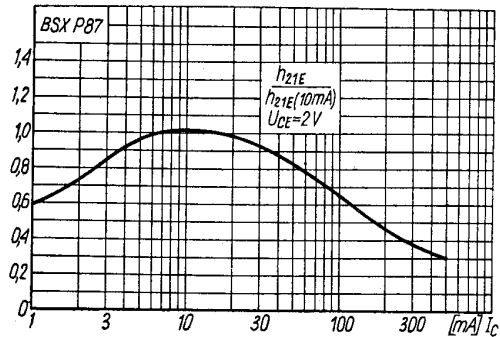
Charakterystyki wyjściowe  $I_C(U_{CE}); I_B$  — parametr



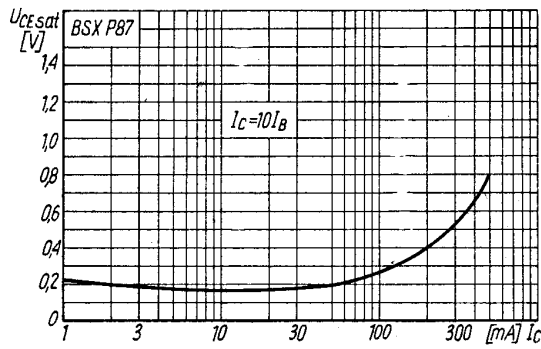
Charakterystyki wyjściowe  $I_C(U_{CE}); I_B$  — parametr



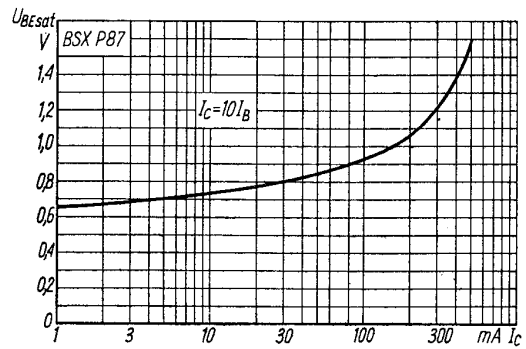
Charakterystyka przejściowa  $I_C(U_{BE})$



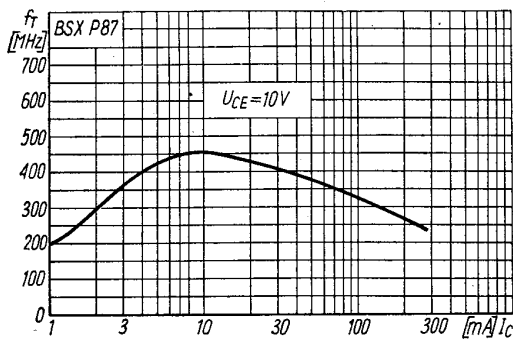
Zależność współczynnika wzmocnienia prądowego od prądu kolektora



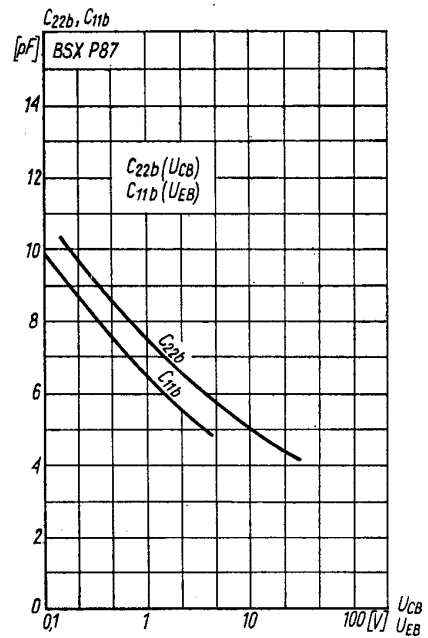
Zależność napięcia nasycenia kolektor-emitery od prądu kolektora



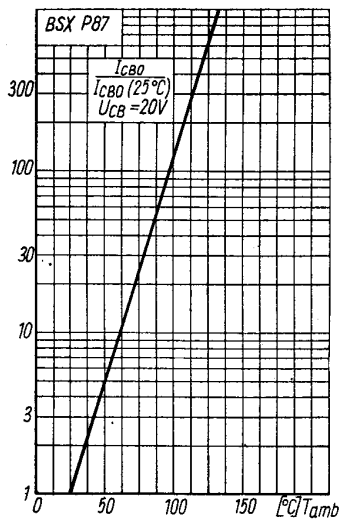
Zależność napięcia nasycenia baza-emitery od prądu kolektora



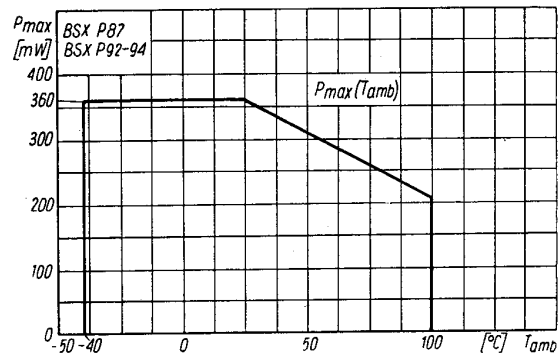
Zależność częstotliwości przenoszenia od prądu kolektora



Zależności pojemności kolektora i emitery od napięcia kolektora i emitery ;



Zależność prądu wstecznego kolektora od temperatury



Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM  
PÓLPRZEWODNIKÓW

Zakład Doświadczalny Półprzewodników przy ITE  
ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa  
telefon: 431431 do 39, telex: 813219



LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

[LittleDiode.com](http://LittleDiode.com)

Looking forward to providing you with the best possible service.